

样品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称/customer name	
产品型号/ Model	TDT-8338-3S 5A NMC
产品规格/ Specification	L50*W15.8*T4mm MAX
主要器件 Main configuration	IC: CM1033-DS/SOP-8 MOS: 3080K/TO-252
PCB工艺/PCB	双层, 绿油,喷锡, ROHS
Document NO.	
版本/ Rev	00

部门 Department	编写(R&D) Registered	审核 (R&D) Checked	复核 (Quality) Deliberation	批准(R&D) Approved
签名/Sign	唐红波			
日期/DATE	2024-11-25			

客户确认 Customer Approve			
部门 Department	R&D	Quality	Approved
签名/Sign			
日期/DATE			
文件有效期限 Approved date	有限期限为 1 年 Period of validity 1 year		

在文件到期前一个月如果双方都对此文件都没有异议，此文件将自动延续有效期1年
If both sides have no dissidence in one month before the maturity of the Approved. It will be considered valid automatically for a one year period.

公司名称 The name of company	深圳市拓达通电子有限公司	电话 TEL	
-----------------------------	--------------	-----------	--

公司地址 Address	深圳市光明区白花社区兴华雄科技园A9栋4楼
-----------------	-----------------------

1. 产品变更履历/Product Modified Record List

产品变更履历/ Product Modified Record List			
日期/ Date	变更点描述/ Problem and Solution	责任人/ Principal	
2024-11-25	1. 新开发		

2. 产品规格/ Produce Specification

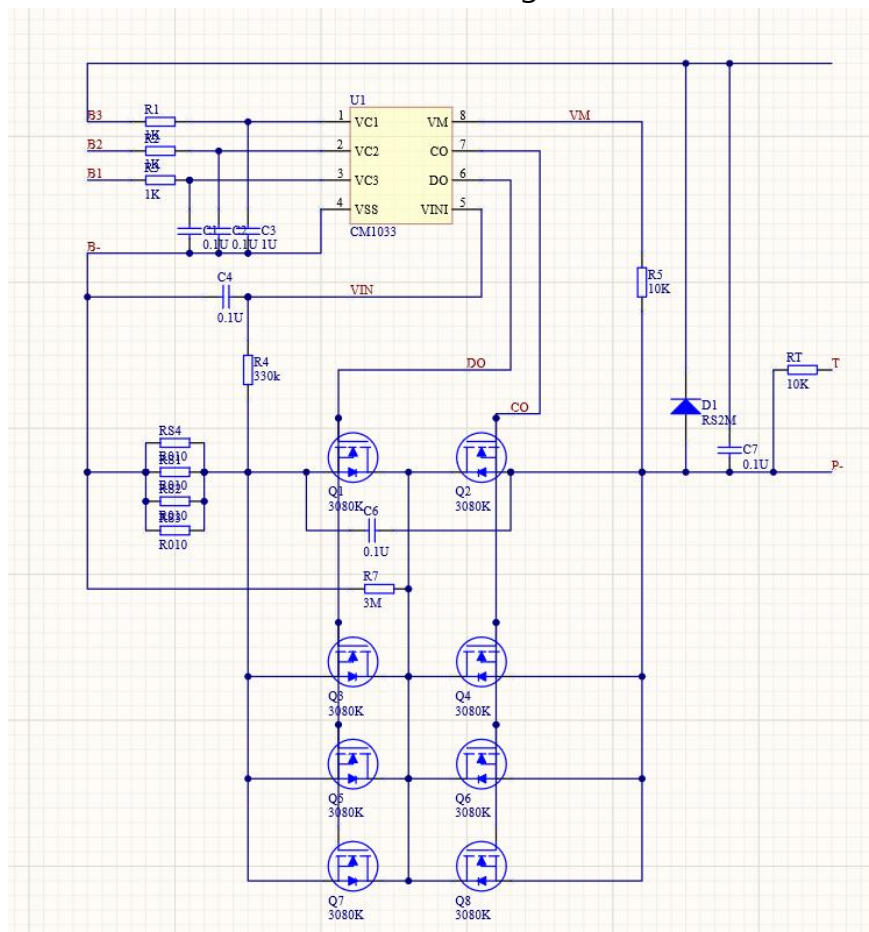
	技术规范 TECHNICAL SPECIFICATION FOR APPROVAL	Rev	0.1
		Date	
		Page	1

No	项目 Item	单位 Unit	最小值 Min.	中间值 Typ.	最大值 Max.	备注（Remark）
1	过充保护电压 Over charge protection voltage	V	4. 225	4. 25	4. 275	来源IC规范 Source of IC spec
2	过充保护延时时间 Delay time for over charge protection	mS	500	1000	1500	来源IC规范 Source of IC spec
3	过充电解除电压 Over charge release voltage	V	4. 0	4. 05	4. 1	来源IC规范 Source of IC spec
	过充解除恢复方法 Over charge release method	移开充电，并且电芯电压<过充保护解除电压				
4	过放电保护电压 Over discharge protection voltage	V	2. 62	2. 7	2. 78	来源IC规范 Source of IC spec
5	过放保护延时时间 Delay time for over discharge protection	mS	500	1000	1500	来源IC规范 Source of IC spec
6	过放电解除电压 Over discharge release voltage	V	2. 9	3. 0	3. 1	来源IC规范 Source of IC spec
	过放电解除方法 Over discharge release method	连接上充电器，并电芯电压>过放解除电压				
	建议最大持续充/放电电流 max continuous charge/discharge current	A	5A			
7	放电过流保护测试值 Discharge Over current protection testing values	A	15	20	25	来源IC\MOS规范 Source of IC \MOSspec
8	放电过电流保护延迟时间 Delay time for discharge over current protection	mS	64	128	192	来源IC规范 Source of IC spec
9	充电过流保护测试值 Charge Over current protection testing values	A	5	10	15	I=VM/Rss（MOS内阻） I=Cs/Rss（电阻）
10	充电过流保护延迟时间 Delay time for charge over current protection	mS	6	12	24	来源IC规范 Source of IC spec
11	短路保护延迟时间 Delay time for short circuit protection	uS	100	300	600	来源IC规范 Source of IC spec

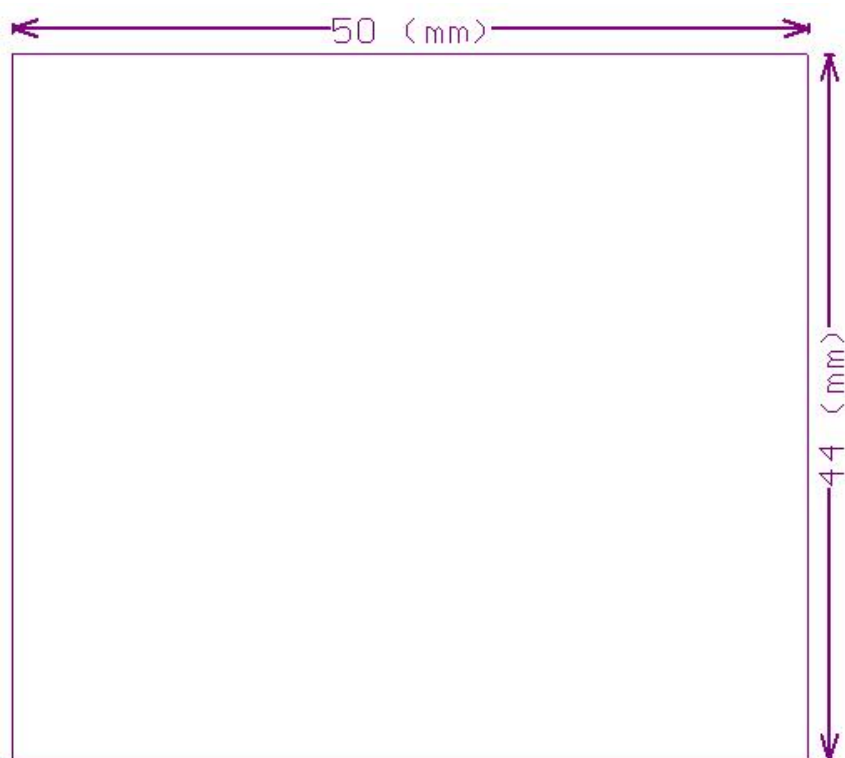
12	保护电路的功耗 Power consumption of protection circuit	uA	2	7	12	来源IC规范 Source of IC spec
13	PCM负极内阻 PCM Internal Resistance	mΩ	/	/	60	元件+PCB内阻
14	NTC电阻器 NTC resistor	kΩ	/	/	/	来源NTC规范25℃
15	ID电阻器 ID resistor	kΩ	/	/	/	来源电阻规范25℃
16	静电测试 ESD test	KV	直接接触±8KV各10次 空气接触±15KV各10次			打静电测试后,保护板不能瞬间保护,元器件也不能出现性能不良的情况。
17	休眠功能 Sleep function	有YES				来源IC规范 Source of IC spec
18	0V充电功能 0V charge function	有YES				来源IC规范 Source of IC spec

4. 图纸/Drawing

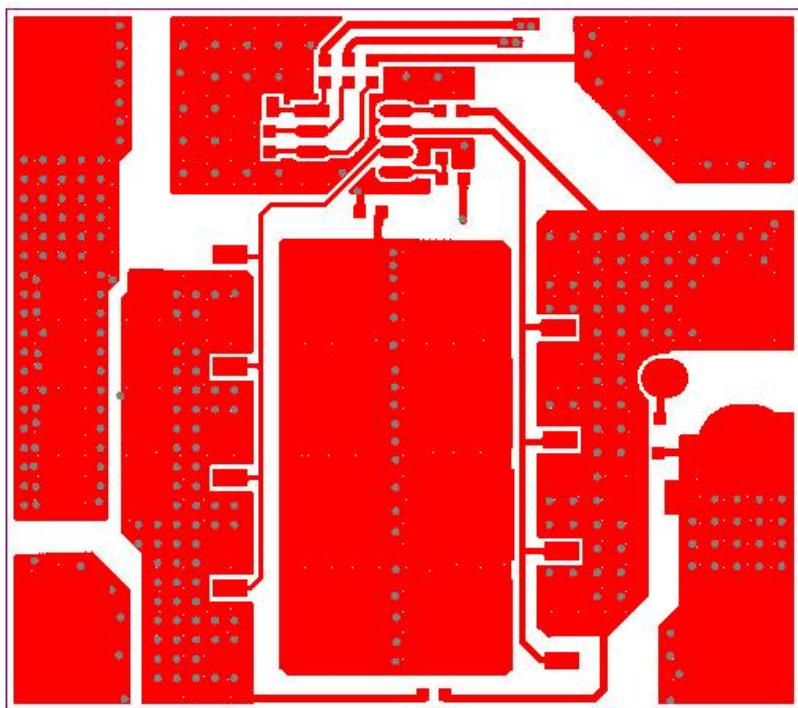
4.1 电气原理图/Circuit Drawing



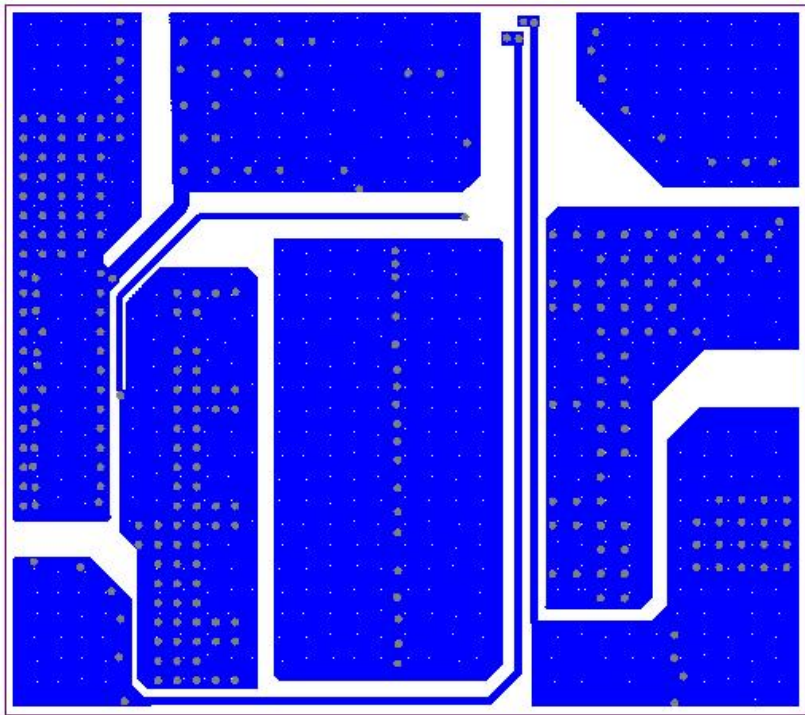
4.2 尺寸图



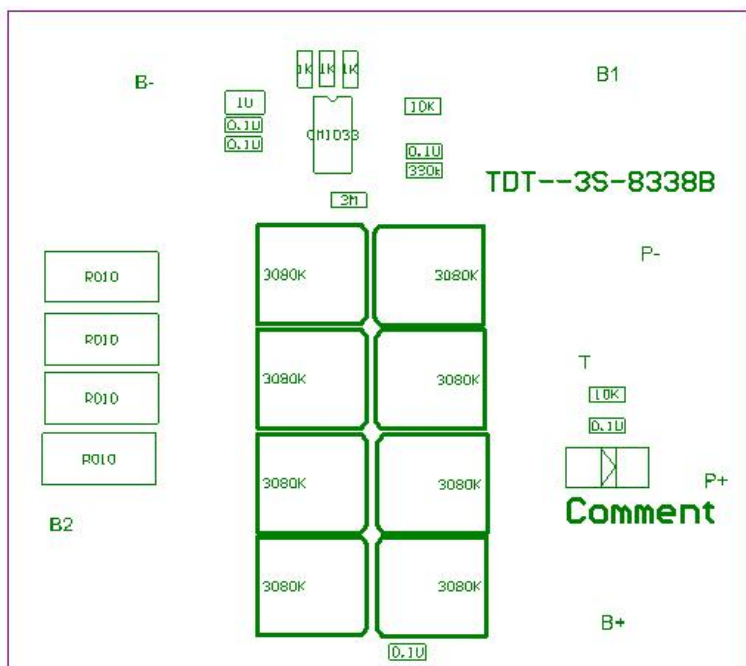
4.3 顶层线路图/Top Layer



4.4 底层线路图/Bottom Layer



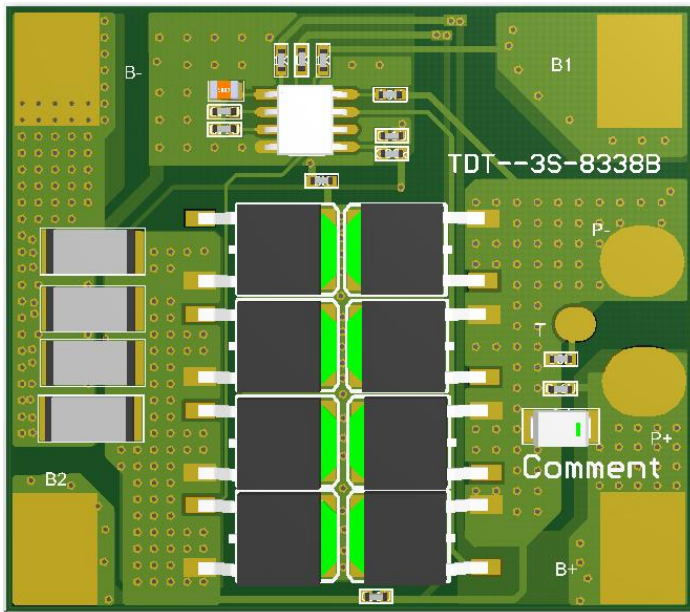
4.5 顶层丝印图/Top Overlayer



底层丝印图/Bottom Overlay



接线说明:



- B- 接电芯的B- 0V
- B1+ 接电芯的 3.7V
- B2+ 接电芯的 7.4V
- B+ 接电芯的B+ 11.1V
- P+ 接负载+/充电器+
- P- 接接负载-/充电器-